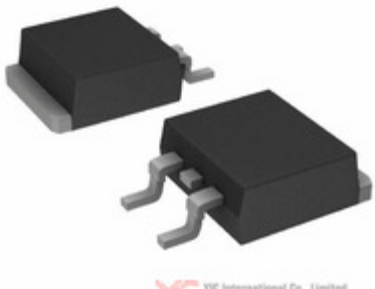

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHB33N60ET5-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHB33N60ET5-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 33A TO263
	Datenblätter:  SIHB33N60ET5-GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	




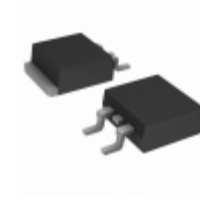



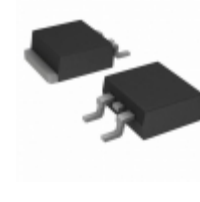
Spezifikationen

Teilenummer	SIHB33N60ET5-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3508pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 33A (Tc) 278W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SIHB33N60ET5-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB33N60ET5-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB33N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHB33N60ET5-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB35N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>	 <p>SIHB33N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p>SIHB33N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>
 <p>SIHB33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>	 <p>SIHB8N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>	 <p>SIHB6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB33N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHB33N60ET5-GE3 Datenblatt	SIHB33N60ET5-GE3-Datenblätter	SIHB33N60ET5-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHB33N60ET5-GE3
SIHB33N60ET5-GE3 Electronic	SIHB33N60ET5-GE3-Komponenten	SIHB33N60ET5-GE3-Verteiler	SIHB33N60ET5-GE3-Bild	SIHB33N60ET5-GE3-Teil
SIHB33N60ET5-GE3 Preis	SIHB33N60ET5-GE3 Hersteller	SIHB33N60ET5-GE3 Bild	SIHB33N60ET5-GE3 Aktie	SIHB33N60ET5-GE3 Inventar
SIHB33N60ET5-GE3 Neu	SIHB33N60ET5-GE3 Original	SIHB33N60ET5-GE3 garantiert	SIHB33N60ET5-GE3 RFQ	SIHB33N60ET5-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited